

## Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Лагов Петр Борисович
2	Дата рождения ( <b>полная</b> )	27.06.1973
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор технических наук (специальность 05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нано-электроника, приборы на квантовых эффектах)
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор (по кафедре)
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	111250, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 russianspacesystems.ru contact@spacecorp.ru
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Акционерное общество «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»
	Ведомственная принадлежность организации	Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»
	Тип организации	Акционерное общество
	Наименование подразделения	Научный центр сертификации элементов и оборудования НЦ СЭО
	Должность	Начальник отдела
7	Основные публикации в области диссертационного исследования	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polyakov A. Y., Schemerov I. V., Vasilev A. A., Romanov A. A., <b>Lagov P. B.</b>, Miakonkikh A. V., Chernykh A. V., Romanteeva E. P., Chernykh S. V., Rabinovich O. I., Pearton S. J. Trap states and hydrogenation of implanted Si in semi-insulating Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Fe) // Journal of vacuum science and technology A. – 2025. – Vol. 43. – № 3. DOI 10.1116/6.0004463</li> <li>2. Schemerov I. V., <b>Lagov P. B.</b>, Kobeleva S. P., Kirilov V. D., Drenin A. S., Mescheryakov A. A. Optimization of the transient characteristics of the rectifiers under high-energy electron irradiation // Instruments and experimental techniques. – 2024. – Vol. 67. – № 3. – P. 587–592. DOI 10.1134/S0020441224700866</li> <li>3. Щемеров И. В., <b>Лагов П. Б.</b>, Кобелева С. П., Кирилов В. Д., Дренин А. С., Мещеряков А. А. Определение пределов оптимизации переходных характеристик выпрямительных диодов при облучении высокоэнергетическими электронами // Приборы и техника эксперимента. – 2024. – № 3. – С. 139–144. DOI 10.31857/S0032816224030197</li> <li>4. Касимова В. М., Козлова Н. С., Забелина Е. В., Бузанов О. А., <b>Лагов П. Б.</b>, Павлов Ю. С., Кулевой Т. В., Столбунов В. С. Влияние облучения протонами на оптические свойства и дефектообразование в кристаллах Gd<sub>3</sub>Al<sub>x</sub>Ga<sub>5-x</sub>O<sub>12</sub> (x = 2, 3) // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 2024. – № 1. – С. 71–76. DOI 10.31857/S1028096024010109</li> </ol>	

	<p>5. Aslanov L.A., Zaitsev V.B., Zakharov V.N., Kudryavtsev I.K., Senyavin V.M., <b>Lagov P.B.</b>, Romantseva E.P. Nanosilicon stabilized with ligands: Effect of high-energy proton beam on luminescent properties // Surface and Interface Analysis. – 2024. DOI 10.1002/sia.7354</p> <p>6. Kasimova V.M., Kozlova N.S., Zabelina E.V., Buzanov O.A., <b>Lagov P.B.</b>, Pavlov YU.S., Kulevoy T.V., Stolbunov V.S. Effect of proton irradiation on the optical properties and defect formation in <math>Gd_3Al_xGa_{5-x}O_{12}</math> (<math>x = 2, 3</math>) crystals // Journal of surface investigation: X-Ray, synchrotron and neutron techniques. – 2024. – Vol. 18. – № 1. – P. 58–62. DOI 10.1134/S1027451024010105</p> <p>7. Polyakov A.Y., Saranin D.S., Shchemerov I.V., Vasilev A.A., Romanov A.A., Kochkova A.I., Gostischev P., Chernykh A.V., Alexanyan L.A., Matros N.R., <b>Lagov P.B.</b>, Doroshkevich A.S., Isayev R.SH., Pavlov YU.S., Kislyuk A.M., Yakimov E.B., Pearton S.J. Proton irradiation Of <math>Ga_2O_3</math> Schottky diodes and <math>NiO/Ga_2O_3</math> heterojunctions// Scientific Reports. – 2024. – Vol. 24. – № 1. – P. 27936 DOI 10.1038/s41598-024-78531-y</p> <p>8. Запетляев В.М., Жуков А.А., <b>Лагов П.Б.</b>, Якухин С.Д. Экспериментальная оценка радиационной стойкости СВЧ-фильтров космического назначения на основе высокоомного кремния // Успехи прикладной физики. – 2024. – Т. 12. – № 6. – С. 547–555. DOI 10.51368/2307-4469-2024-12-6-547-555</p> <p>9. <b>Лагов П.Б.</b>, Мещеряков А.А., Дренин А.С., Павлов Ю.С., Ромانتеева Е.П. Исследование технологических режимов радиационно-термической обработки на основе облучения высокоэнергетическими электронами для повышения радиационной стойкости субмикронных микросхем // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. – 2024. – Т. 11. – № 1. – С 95–102. ссылка: <a href="https://www.elibrary.ru/item.asp?id=67852131">https://www.elibrary.ru/item.asp?id=67852131</a></p> <p>10. Мещеряков А.А., Дренин А.С., Сирбаев Р.Ю., Селин Д.С., <b>Лагов П.Б.</b>, Павлов Ю.С., Иванов Е.М., Американов Д.А., Кулевой Т.В., Столбунов В.С., Ромانتеева Е.П., Петров К.К. Повышение радиационной стойкости микроконтроллеров к воздействию высокоэнергетичных протонов с помощью радиационно-термической обработки // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. – 2024. – Т. 11. – № 4. – С. 85–93. ссылка: <a href="https://www.elibrary.ru/item.asp?id=79604138">https://www.elibrary.ru/item.asp?id=79604138</a></p> <p>11. Щемеров И.В., Поляков А.Я., <b>Лагов П.Б.</b>, Кобелева С.П., Кочкова А.И., Куланчиков Ю.О., Дорошкевич А.С., Кирилов В.Д. Влияние центров захвата, внесенных облучением протонами с энергией 1 МэВ, на время восстановления обратного тока в диодах Шоттки на основе <math>Ga_2O_3</math> // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2023. – Т. 89. – № 7. – С 25–33. DOI 10.26896/1028-6861-2023-89-7-25-33</p>
8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты